



Toshiba presenta SSDs en un solo paquete con memoria flash 3D de 64 capas

Los nuevos SSD sBG3 NVMe ^[1] ofrecen un diseño ultracompacto que permite que la informática móvil y los dispositivos IoT sean más pequeños, más ligeros, más rápidos y más eficientes

Düsseldorf, Alemania, 03 de agosto de 2017 - Toshiba Electronics Europe GmbH ha anunciado hoy la disponibilidad de la puntera serie BG3, su línea de producto SSDs (Solid State Drive) de última generación, en un sólo paquete BGA (Ball Grid Array) está basada en BiCS FLASH de 3 bits por celda TLC (Triple Level Cell) de 64 capas de Toshiba. Diseñadas para alimentar el futuro de los dispositivos móviles, las unidades SSD BG3 de Toshiba ofrecen un mejor rendimiento ^[2] y un tamaño más pequeño que las tradicionales unidades basadas en SATA. Además, con su diseño económico sin DRAM, la exclusiva serie BG3 permite una experiencia de usuario de alta calidad a una fracción del consumo de energía de otras unidades SSD NVMe Express ^[3] (NVMe) ^[4].

La serie BG3 de Toshiba aprovecha la función HMB (Host Memory Buffer) en NVMe Revision 1.2.1 para mantener un alto rendimiento sin DRAM integrada, utilizando la memoria del host para propósitos de gestión de flash. Esta potente combinación permite a los dispositivos aprovechar el rendimiento del almacenamiento NVMe al tiempo que maximiza la huella y la asequibilidad para ofrecer una experiencia móvil de próxima generación a los usuarios finales. Las rápidas y económicas unidades SSD miniaturizadas, también ofrecen aplicaciones para

centro de datos y enterprise, una solución alternativa para el almacenamiento de arranque del servidor.

Con el estilo y la portabilidad en mente en los fabricantes de portátiles y tabletas de hoy en día, la serie BG3 fue diseñada específicamente para permitir dispositivos aún más finos y más eficientes. Al eliminar DRAM de su diseño, la serie BG3 de Toshiba ofrece las unidades SSD más finas del mundo ^[5] disponibles con tan solo 1,3 mm de alto y ofrece un consumo de energía más bajo para maximizar la duración de la batería.

Las unidades BG3 SSDs de Toshiba son de pequeño tamaño, pero no de rendimiento. Con una arquitectura PCI Express (PCIe) ^[6] Gen3 x2 lane y una arquitectura NVMe Revision 1.2.1, BG3 ofrece hasta 1520 MB / s de lectura secuencial, 2.7 veces el ancho de banda máximo teórico de SATA 6Gbit / s y hasta 840 MB / S de escritura secuencial ^[7], 1,5 veces el ancho de banda máximo teórico de SATA 6 Gbit / s. Además, BG3 también ofrece caché SLC para un rendimiento excelente para acelerar las cargas de trabajo tipo ráfaga, como las que se experimentan rutinariamente en PCs basados en Windows ^[8].

La serie BG3 ultra compacta está disponible en capacidades de 128GB, 256GB y 512GB ^[9]. Los tres modelos están disponibles en un formato de montaje en superficie BGA (M.2 1620) o como módulo extraíble (M.2 2230) para obtener flexibilidad del diseño de la plataforma.

"Las unidades SSD de tercera generación BG de Toshiba son ideales para la informática móvil e IoT y el uso en centros de datos por igual", afirma Paul Rowan, Gerente de Toshiba Electronics Europe, Unidad de Negocio SSD. "Especialmente en los centros de datos, el despliegue de BG3 puede reducir considerablemente tanto los gastos de capital como los de operación, ya que la nueva serie BG3 supera la brecha de potencia y precio entre SATA enterprise y los SSDs NVMe de clientes convencionales, al mismo tiempo que ofrece almacenamiento de arranque con consumo de energía mejorado y una huella compacta" Concluye.

El diseño de un solo paquete de BG3 cuenta con un controlador y firmware desarrollado por Toshiba, estrechamente integrado con la memoria Flash Toshiba y optimizado para rendimiento, baja potencia y fiabilidad. Para resolver las necesidades de seguridad modernas, las opciones de unidad de cifrado automático (SED) con TCG ^[10] Opal Versión 2.01 están disponibles.

Se están enviando muestras de la serie BG3 a los clientes y será mostrada en la Flash Memory Summit 2017 en Santa Clara, CA, EE.UU., del 8 al 10 de agosto en el stand # 407.

Para obtener más información sobre la línea de SSDs líder de la industria de Toshiba, visite: <https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/storage-products.html> .

Notas:

[1] NVMe es una marca registrada de NVM Express, Inc.

[2] Velocidades de transferencia de lectura / escritura secuenciales más rápidas

[3] NVM Express y el logotipo de NVM Express son marcas registradas.

[4] Comparado con SSDs M.2 2280 y SSDs M2 1620/2230 que contienen DRAM

[5] Modelos de 128GB y 256GB BGA; Encuesta de Toshiba Memory Corporation, del 3 de agosto de 2017

[6] PCI EXPRESS y PCIe son marcas comerciales registradas de PCI-SIG.

[7] Encuesta de Toshiba Memory Corporation basada en velocidades de lectura y escritura secuenciales de 128KiB, utilizando modelos 512GB de la serie BG3 bajo las condiciones de prueba de Toshiba Memory Corporation. La velocidad de lectura y escritura puede variar dependiendo del dispositivo host, las condiciones de lectura y escritura y el tamaño del archivo. Toshiba Memory Corporation define un megabyte (MB) como 1.000.000 bytes y un kibibyte (KiB) como 210 bytes, o 1.024 bytes. El rendimiento secuencial de lectura y escritura mencionado en este documento son datos de referencia, y pueden variar con los datos del producto BG3 en la hoja de datos.

[8] Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o en otros países.

[9] Definición de capacidad: Toshiba Memory Corporation define un gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes. Un sistema operativo de computadora, sin embargo, informa capacidad de almacenamiento con potencias de 2 para la definición de 1 GB = 230 bytes = 1,073,741,824 bytes, y por lo tanto muestra menos capacidad de almacenamiento.

^[10] Trusted Computing Group

* Los nombres de compañías, nombres de productos y nombres de servicio mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

###

Acerca de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe](#) (TEE) es la empresa europea de componentes electrónicos de [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#). TEE ofrece una amplia gama de productos de Cis y discretos que incluyen memorias de gama alta, microcontroladores, circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC) y productos estándar para una aplicación específica (ASSP) para aplicaciones de automoción, multimedia, industriales, de telecomunicaciones y de redes. La empresa también dispone de una amplia gama de soluciones de semiconductores de potencia, así como productos de almacenamiento de datos como HDDSs, SSDs, tarjetas SD y unidades USB.

TEE se fundó en 1973 en Neuss, Alemania, para ofrecer diseño, producción, marketing y ventas, y tiene ahora su sede central en Düsseldorf, Alemania, con sucursales en Francia, Italia, España, Suecia y el Reino Unido. TEE tiene unos 300 empleados en Europa. El presidente de la empresa es el Sr. Akira Morinaga. Para obtener más información, visite el sitio web de TEE en www.toshiba.semicon-storage.com.

Información de contacto para publicaciones:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com

E-mail: spdinfo@tee.toshiba.de

Información de contacto para la redacción:

Barbara Mutz-Gutorski, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 5296 576

E-mail: BMutzGutorski@tee.toshiba.de

Publicado por:

Birgit Schoeniger / Georgia Sorrel, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554 / +44 (0) 20 8429 6549

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com or georgia.sorrel@publitek.com

August 2017

Ref. TBS012/A